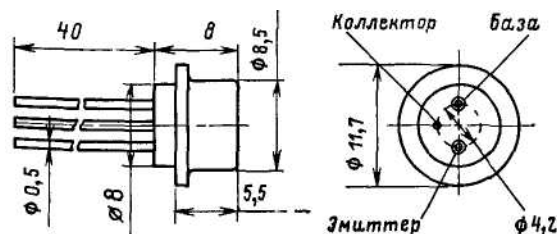


1Т335А, 1Т335Б, 1Т335В, 1Т335Г, 1Т335Д

Транзисторы германиевые диффузионно-сплавные *p-n-p* СВЧ переключательные маломощные. Предназначены для применения в схемах переключения. Выпускают в металлокерамическом корпусе с гибкими выводами. Обозначение типа приводится на боковой поверхности корпуса. Масса транзистора не более 2,2 г.



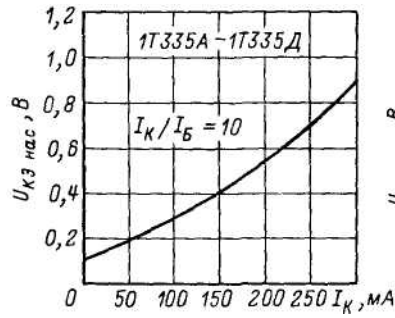
Электрические параметры

Граничная частота при $U_{КБ} = 5$ В, $I_Э = 10$ мА, не менее	300 МГц
Постоянная времени цепи обратной связи при $U_{КБ} = 5$ В, $I_Э = 5$ мА, $f = 5$ МГц, не более	700
Время рассасывания при $I_{к нас} = 10$ мА, $I_Б = 0,5$ мА, не более:	
1Т335А	100 нс
1Т335В, 1Т335Д	150 нс
типичное значение	
1Т335А	75 нс
1Т335В, 1Т335Д	82 нс
Статический коэффициент передачи тока в схеме с общим эмиттером при $U_{кб} = 3$ В, $I_к = 50$ мА:	
при $T = +25^\circ\text{C}$	
1Т335А, 1Т335В	40-70
1Т335Б, 1Т335Г	60-100
1Т335Д	50-100
при $T = -60^\circ\text{C}$	от 0,6 до 1,4 значения при $T = +25^\circ\text{C}$
при $T = +70^\circ\text{C}$	
1Т335А, 1Т335В	от 0,9 до 1,5 значения при $T = +25^\circ\text{C}$
1Т335Б, 1Т335Г, 1Т335Д	от 0,9 до 1,7 значения при $T = +25^\circ\text{C}$
Граничное напряжение при $I_Э = 10$ мА не менее:	
1Т335А, 1Т335Б	13 В
1Т335В, 1Т335Г, 1Т335Д	10 В
типичное значение	
1Т335А, 1Т335Б	14,5 В
1Т335В, 1Т335Г, 1Т335Д	12,5 В
Напряжение насыщения коллектор-эмиттер при $I_к = 250$ мА, $I_Б = 25$ мА не более	
1Т335А, 1Т335Б	2 В
1Т335В, 1Т335Г, 1Т335Д	1,5 В
типичное значение	0,72 В
Напряжение насыщения база-эмиттер при $I_к = 10$ мА, $I_Б = 1$ мА не более	
типичное значение	0,36 В
Обратный ток коллектора не более:	
при $T = +25^\circ\text{C}$, $U_{кб} = 20$ В	10 мкА
при $T = +70^\circ\text{C}$, $U_{кб} = 15$ В	100 мкА
Обратный ток эмиттера не более:	
1Т335А, 1Т335Б, 1Т335В, 1Т335Г:	

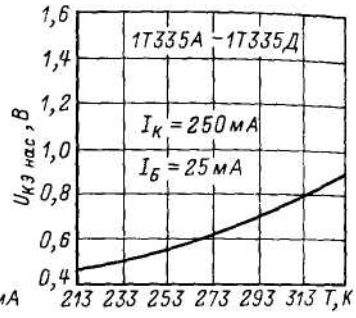
	при $U_{эб} = 2,5 \text{ В}$	5 мА
	при $U_{эб} = 3 \text{ В}$	10 ма
1Т335Д	при $U_{эб} = 2 \text{ В}$	60 мкА
	при $U_{эб} = 3 \text{ В}$	1 мА
Емкость коллекторного перехода при $U_{кб} = 5 \text{ В}$, не более		
1Т335А, 1Т335Б		8,5 пф
1Т335В, 1Т335Г, 1Т335Д		10 пф
Емкость эмиттерного перехода при $U_{эб} = 1 \text{ В}$, не более		35 пФ

Предельные эксплуатационные данные

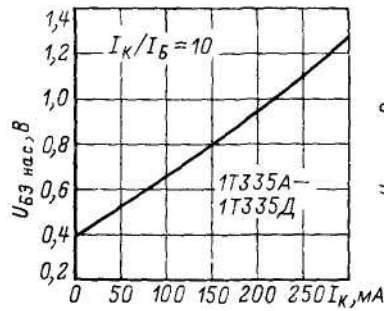
Постоянное напряжение коллектор-база		
при $T = +45^\circ\text{C}$		20 В
при $T = +70^\circ\text{C}$		15 В
Постоянное напряжение коллектор-эмиттер при $U_{кб} = 0,5 \text{ В}$		
при $T = +45^\circ\text{C}$		19 В
при $T = +70^\circ\text{C}$		14 В
Постоянное напряжение коллектор-эмиттер при $R_{бэ} = 1 \text{ кОм}$		
1Т335А, 1Т335Б		
при $T = +45^\circ\text{C}$		17 В
при $T = +70^\circ\text{C}$		14 В
1Т335В, 1Т335Г, 1Т335Д		
при $T = +45^\circ\text{C}$		14 В
при $T = +70^\circ\text{C}$		11 В
Постоянное напряжение эмиттер-база		
при $T = +45^\circ\text{C}$		3 В
при $T = +70^\circ\text{C}$		2,5 В
Импульсное напряжение коллектор-база при $U_{эб} < 2 \text{ В}$, $t_i < 10 \text{ мкс}$, $Q > 10$		
1Т335А, 1Т335Б		
при $T = +45^\circ\text{C}$		35 В
при $T = +70^\circ\text{C}$		30 В
1Т335В, 1Т335Г, 1Т335Д		
при $T = +45^\circ\text{C}$		30 В
при $T = +70^\circ\text{C}$		25 В
Импульсное напряжение коллектор-эмиттер при $U_{эб} > 0,5 \text{ В}$, $t_i < 10 \text{ мкс}$, $Q > 10$		
при $T = +45^\circ\text{C}$		25 В
при $T = +70^\circ\text{C}$		20 В
Импульсное напряжение эмиттер-база при $t_i < 250 \text{ мкс}$, $Q > 10$		
при $T = +45^\circ\text{C}$		4 В
при $T = +70^\circ\text{C}$		3,5 В
Постоянный ток коллектора		
при $T = +45^\circ\text{C}$		150 мА
при $T = +70^\circ\text{C}$		100 мА
Импульсный ток коллектора при $t_i < 50 \text{ мкс}$, $Q > 5$		
при $T = +45^\circ\text{C}$		250 мА
при $T = +70^\circ\text{C}$		150 мА
Постоянная рассеиваемая мощность		
при $T = +45^\circ\text{C}$		200 мВт
при $T = +70^\circ\text{C}$		67 мВт
Импульсная рассеиваемая мощность при $U_{кэ} < U_{кэ.огр}$, $t_i < 50 \text{ мкс}$, $Q > 5$		
при $T = +45^\circ\text{C}$		500 мВт
при $T = +70^\circ\text{C}$		350 мВт
Общее тепловое сопротивление		300 °С/В
Температура перехода		+90°С
Температура окружающей среды		от -60 до +70°С



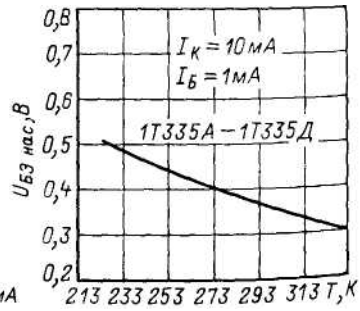
Зависимость напряжения насыщения коллектор-эмиттер от тока коллектора.



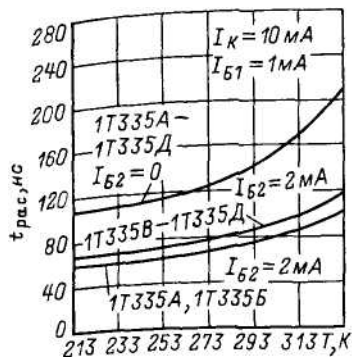
Зависимость напряжения насыщения коллектор-эмиттер от температуры



Зависимость напряжения насыщения база-эмиттер от тока коллектора.



Зависимость напряжения насыщения база-эмиттер от температуры.



Зависимость времени рассасывания от температуры

